

AT88SC102 卡简介

一、主要指标：

- 1 两个 512 位存储区
- 1 带加密逻辑 1K 位串行 EEPROM
- 1 采用低功耗 CMOS 工艺
- 1 2 字节密码，密码错误计数：4 次
- 1 温度范围：-25 ~70
- 1 10 万次擦写次数
- 1 100 年数据保存期

二、存储区分配：

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F

三、保密特性

AT88SC102 有熔断操作，熔丝熔断前后保密特性不同，熔断前，整卡的访问受用户密码及各应用区读属性控制位的控制；熔断后，卡的访问受用户密码、各分区擦除密码、及各应用区读写属性控制位的控制。

存储分区	字节地址	字节数	熔丝熔断前	熔丝熔断后
FZ	厂方代码	0~1 2	出厂时已固化，可读，不可更改	可读，不可更改。
IZ	发行商代码	2~9 8	可读，可反复擦写	固化，不可更改
SC	用户密码	10~11 2	用户密码校验正确后，可读，可更改	不可读，但可更改
FAC	密码错误计数器	12~13 2	初始值为 4，总密码校对出错 1 次，则计数器值减 1，连续 4 次出错，卡片会自动锁死，如果其中有 1 次对，则恢复为 4	特性同熔断前
CPZ	代码保护区	14~21 8	用户密码校验成功后，可读、可擦、可写	特性同熔断前
ATTR1	应用区一读写属性控制	22 1	第 1 位为写属性控制位 PR 第 2 位为读属性控制位 RD	特性同熔断前
AZ1	应用区一	23~85 63	读：当 RD 置为“1”时，任何情况下可读当 RD 为置“0”时，用户密码核对正确后，可读写：用户密码核对正确后，可写 PR 熔断前不起作用擦：用户密码核对正确后，可擦，熔断前擦除密码不起作用读：同熔丝前写：当 PR 置为“1”，用户密码校对正确后，可写当 PR 置为“0”，任何情况下不可写擦：用户密码核对正确，应用区一擦除密码核对正确，则整区擦除。	
EZ1	应用区一擦除密码	86~91 6	用户密码校验正确后，可读，可更改	不可读，不可更改
ATTR2	应用区二读写属性控制	92 1	特性同 ATTR1	特性同 ATTR1
AZ2	应用区二	93~155 63	特性同 AZ1	特性同 AZ1
EZ2	应用区二擦除密码	156~159 4	特性同 EZ1	特性同 EZ1
EC	应用区二擦除密码计数器	160~175 16	熔断前不起作用	熔断后，AZ2 每擦除 1 次，则计数器减 1，共可擦 128 次
测试区	176~177 2		任何情况下，可读，可擦，可写	任何情况下可读，可擦写
合计		178		